



SEMICONDUCTOR

TECHNICAL DATA

東芝トランジスタ TOSHIBA TRANSISTOR

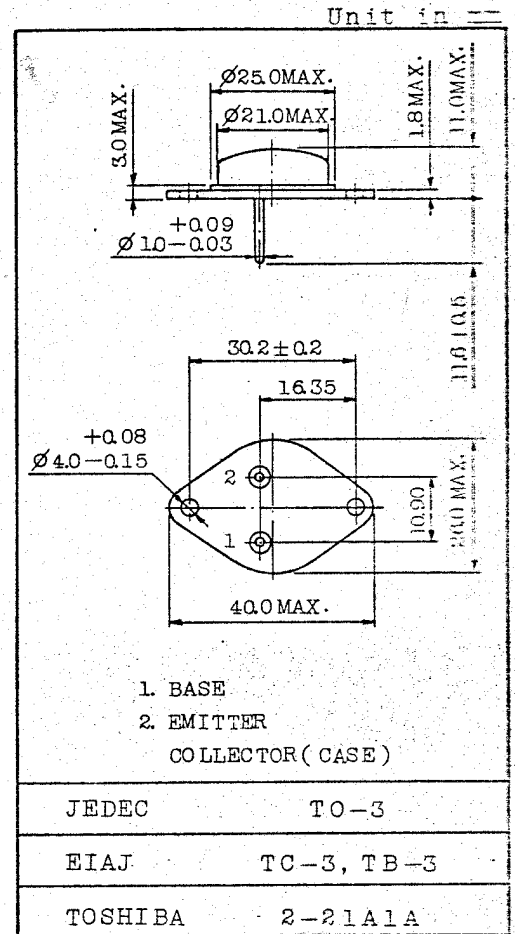
2SC2461A

SILICON NPN EPITAXIAL TYPE (PCT PROCESS)**

TENTATIVE

○ 電力増幅用

- Power Amplifier Applications.
- 高耐圧です。 $V_{CEO} = 160V$ (MIN.)
- トランジション周波数が高い。 $f_T = 80MHz$ (TYP.)
- 2SA1051A とコンプリメンタリになります。
- 100W Hi-Fi オーディオ・アンプに最適です。
- Complementary to 2SA1051A.
- Recommended for 100W High-Fidelity Audio Frequency Amplifier Output Stage.



最大定格 MAXIMUM RATINGS ($T_a = 25^\circ C$)

CHARACTERISTIC	SYMBOL	RATING	UNIT
コレクタ・ベース間電圧	V_{CBO}	160	V
コレクタ・エミッタ間電圧	V_{CEO}	160	V
エミッタ・ベース間電圧	V_{EBO}	5	V
コレクタ電流	I_C	15	A
エミッタ電流	I_E	-15	A
コレクタ損失 ($T_c = 25^\circ C$)	P_C	150	W
接合温度	T_j	150	$^\circ C$
保存温度	T_{stg}	-65~150	$^\circ C$

アクセサリは AC73 を適用
MOUNTING KIT NO. AC73

** PCT 技術により製造されています。



SEMICONDUCTOR

TECHNICAL DATA

2SC2461A

電気的特性 ELECTRICAL CHARACTERISTICS (Ta=25°C)

CHARACTERISTIC	SYMBOL	CONDITION	MIN.	TYP.	MAX.	UNIT
コレクタシャ断電流	I_{CBO}	$V_{CB}=160V, I_E=0$	—	—	10	μA
エミッタシャ断電流	I_{EBO}	$V_{EB}=5V, I_C=0$	—	—	50	μA
コレクタ・エミッタ間降伏電圧	$V_{(BR)CEO}$	$I_C=0.1A, I_B=0$	160	—	—	V
エミッタ・ベース間降伏電圧	$V_{(BR)EBO}$	$I_E=0.01A, I_C=0$	5	—	—	V
直 流 電 流 増 幅 率	$h_{FE(1)}$	$V_{CE}=5V, I_C=1A$	55	—	240	—
	$h_{FE(2)}$	$V_{CE}=5V, I_C=5A$	40	—	—	—
コレクタ・エミッタ間飽和電圧	$V_{CE(sat)}$	$I_C=5A, I_B=0.5A$	—	—	2.0	V
ベース・エミッタ間電圧	V_{BE}	$V_{CE}=5V, I_C=5A$	—	—	2.0	V
トランジション周波数	f_T	$V_{CE}=10V, I_C=1A$	—	80	—	MHz
コレクタ出力容量	C_{ob}	$V_{CB}=10V, I_E=0$ $f=1MHz$	—	200	—	pF

Note $h_{FE(1)}$ により下表のように分類し、現品表示してあります。

According to the value of h_{FE} the 2SC2461A is classified as follows.

CLASSIFICATION	MIN.	MAX.
2SC2461A-R	55	110
2SC2461A-O	80	160
2SC2461A-Y	120	240